

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成18年11月9日(2006.11.9)

【公開番号】特開2005-119891(P2005-119891A)

【公開日】平成17年5月12日(2005.5.12)

【年通号数】公開・登録公報2005-018

【出願番号】特願2003-353962(P2003-353962)

【国際特許分類】

**C 3 0 B 15/32 (2006.01)**

【F I】

C 3 0 B 15/32

【手続補正書】

【提出日】平成18年9月27日(2006.9.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

炉内に融液が充填されるルツボを設けたチャンバと、該ルツボを加熱するヒータと、前記チャンバ内に設けられたワイヤーとを備えた半導体単結晶製造装置において、

前記ワイヤーの少なくとも高温にさらされる領域を、カラーで覆ったことを特徴とする半導体単結晶製造装置。

【請求項2】

前記カラーを複数に設けたことを特徴とする請求項1に記載の半導体単結晶製造装置。

【請求項3】

前記カラーはワイヤー巻き上げ装置と種結晶との間に設けられていることを特徴とする請求項1又は2に記載の半導体単結晶製造装置。

【請求項4】

前記カラーを前記ワイヤーを覆うように近接させて設けたことを特徴とする請求項1～3の何れか1つに記載の半導体単結晶製造装置。

【請求項5】

前記ワイヤーは先端に連結部材を備え、該連結部材を介してシードホルダを吊持しており、

前記シードホルダは前記チャンバ内で昇降可能であり、

前記シードホルダ若しくは前記連結部材の少なくとも一方の長さを、前記シードホルダに種結晶を取り付け、該種結晶が融液に着液する位置にあるとき、前記ワイヤーの先端近傍で前記連結部材から露出している部分が前記炉内の高温雰囲気下で所定温度未満の範囲に位置する長さとしたことを特徴とする請求項1に記載の半導体単結晶製造装置。

【請求項6】

前記所定温度未満とは700 未満であることを特徴とする請求項5に記載の半導体単結晶製造装置。